



CAS IR Grid / 化学研究所 / 中国科学院化学研究所 / 其它

在含有疏水性的硅柱的硅片表面构筑微电极阵列的方法

文献类型：专利

入库方式：OAI收割

来源：[化学研究所](#)

浏览	下载	收藏
40	0	0

作者 江雷; 苏彬; 王树涛; 马杰

发表日期 2014-12-10

专利号 ZL201110084311.7

专利类型 发明

源URL [<http://ir.iccas.ac.cn/handle/121111/33530>]

专题 化学研究所_其它

作者单位 中国科学院化学研究所

推荐引用方式 江雷,苏彬,王树涛,等. 在含有疏水性的硅柱的硅片表面构筑微电极阵列的方法.

GB/T 7714 ZL201110084311.7. 2014-12-10.

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

» [欧盟学术资源开放存取平台](#) |» [CALIS高校机构知识库](#) |» [台湾学术机构典藏](#) |» [香港机构知识库整合系统](#) | [网站地图](#) | [意见反馈](#)

版权所有 ©2023 中国科学院 - 运行维护：中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace

0931-8270076 发送邮件

陇ICP备2021001824
号-8

甘公网安备 62010202001088号